科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 2 8 年 5 月 3 0 日現在

機関番号: 2 4 4 0 3	
研究種目: 若手研究(B)	
研究期間: 2013 ~ 2015	
課題番号: 2 5 8 7 0 6 2 6	
研究課題名(和文)カルコパイライト構造化合物の高熱電特性機構の解明と新規環境調和型材料への展開	
研究課題名(英文)Clarification of high-thermoelectric properties of chalcopyrite tellurides and suggestion of environmentally-friendly materials with good performance	
研究代表者	
小菅 厚子(KOSUGA, ATSUKO)	
大阪府立大学・21世紀科学研究機構・講師	
研究者番号:3 0 3 7 9 1 4 3	
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円	

研究成果の概要(和文):本研究課題は、申請者ら着目しているカルコパイライト構造化合物の高熱電特性発現機構を 解明し、そこで得た知見を基に、構成元素を環境負荷の低い元素に置き換え、さらに熱電特性を高効率化させる事を目 標とした。最終的には、環境負荷の低い熱電材料として、Cu2ZnSnS4を選定し、320-720 Kでの熱電特性を評価した。こ の材料は、大気中でも不活性雰囲気中と変わらぬ熱電特性を示すことを明らかにした。しかしながら、高温下になると デバイス作成時に電極材料となるPtとなんらかの反応を起こし、ZnS相が分離することから、デバイス作成時には、Cu2 ZnSnS4とPtの間にバリア層が必要なことが示唆された。

研究成果の概要(英文): The aim of this study is clarification of mechanism of high-thermoelectric properties of chalcopyrite tellurides and suggestion of better thermoelectric materials which are comprised of environmentally-friendly materials. As a results, the thermoelectric properties and stability of copper zinc tin sulfide (Cu2ZnSnS4) in air at 300-720 K are evaluated. Cu2ZnSnS4 is chemically stable in air and exhibited a maximum thermoelectric dimensionless figure of merit of 0.1 at 720 K, making it a promising candidate for the p-type leg of thermoelectric devices that operate in air. However, air annealing of Cu2ZnSnS4 with Pt paste induces macroscopic segregation of a ZnS-rich phase, which increases its electrical resistivity. Because Pt is considered a suitable junction material, a barrier material between Cu2ZnSnS4 and Pt paste is needed to realize reliable thermoelectric devices.

研究分野:エネルギー材料工学

キーワード: 熱電材料 カルコパイライト 熱的特性 電気的特性

1.研究開始当初の背景

現在、わが国で消費される一次エネルギー の約70%が廃熱として捨てられている。こう した希薄な廃熱を電気として回収する技術 が熱電発電技術である。熱電材料の性能は、 無次元性能指数 $ZT=S^2\sigma T/\kappa$ で表され、ZT が 大きい材料ほど高い発電効率を示す(ここで、 S, σ, κ, Tはそれぞれゼーベック係数、電気伝 導率、熱伝導率、絶対温度)。これらのパラ メータは、トレードオフの関係にあるため、 ZT の高い熱電変換材料を開発する事は困難 とされてきた。既存熱電変換材料としては、 Bi2Te3, PbTe, CoSb3系材料がZT~1(発電効 率にして約10%程度)という実用化の目安と なる高い性能を示す。しかし、これらはいず れも 1960~1990 年代に発見された材料であ り、様々な理論的・実験的研究の蓄積が既に あり、性能の限界も見えてきている。さらに、 ビスマス、鉛、テルル等の希少・毒性元素を 含む事が、実用化の障壁となっている。した がって、環境負荷の低い元素からなる新しい 熱電変換材料の開発が求められる。

ごく最近カルコパイライト構造を有する テルライド系化合物である CuInTe₂, AgGaTe₂, CuGaTe₂等が中温域(400 K~800 K程度)において ZT=0.5~1.5 の高い特性を 示す事が報告されており [例えば、A. Kosuga et al., APL **100**, 042108 (2012); T. Plrdpring et al., Adv. Mater. **24**, 3622 (2012); A. Yusufu et al., APL **99**, 061902 (2012)]、これらの化合物群が熱電材料として 非常に高いポテンシャルを有する事が明ら かにされてきた。

2.研究の目的

本研究の一つ目の目的は、CuInTe2を含む テルライド系カルコパイライト構造化合物 の優れた熱電特性の起源を明らかにする事 を目的に、結晶構造・バンド構造の観点から この化合物を研究してみるということであ る。二つ目の目的は、テルライド系カルコパ イライト構造化合物元素戦略の立場から改 良し、環境負荷の低い元素から成る熱電材料 を開発することである。本報告書では、二つ 目の目的を達成する材料として Cu2ZnSnS4 に着目し、この化合物の物性について調べた 結果を特に詳細に報告する。

3.研究の方法

多結晶体の Cu₂ZnSnS₄ は、単体元素を真 空封入しアニール処理したインゴットを、粉 末化し放電プラズマ焼結を施すことにより 作製した。この試料について粉末 X 線回折測 定及びリートベルト解析により結晶構造解 析を行い、大気中及び不活性雰囲気中での熱 電特性を評価した。

4.研究成果

図1に、本研究で得られた Cu₂ZnSnS₄の 粉末X線回折パターンとリートベルト解析の 結果を示す。



図1. Cu_2ZnSnS_4 の粉末 X 線回折パターン とリートベルト解析結果. 点線(赤)は、観 測結果であり、実線(緑)はフィットしたデ ータである。緑の縦線は、ケセライト構造を 有する Cu_2ZnSnS_4 のプラッグピークである。 測定に使った波長は、0.42049 である。挿 入図は、ケセライト構造を持つ Cu_2ZnSnS_4 の結晶構造である。空間群は、I-42mであり、 得られた格子定数は、a=5.4343(18), c=10.8393(4)である。

図 1 より、本研究で得られた Cu₂ZnSnS₄のX 線 回 折 パ ターン は ケ セ ラ イ ト 構 造 [P. Bonazzi et al., *Can. Mineral.* **41**, 639 (2003)]と一致することから、本研究で得られ た試料は、単相のケセライト構造を有する Cu₂ZnSnS₄と確認できた。

図 2(a)(b)に、窒素気流下及び大気気流下 での示差熱-熱重量同時測定(TG-DTA)の結果 を示す。窒素気流下では、1170 K で吸熱反 応とともに、急激な重量減少がみられる。 Cu₂SnS₃-ZnS の擬二元系状態図 [I.D.Olekseyuk et al., J. Alloys Compd. 368, 135 (2004).]によると、Cu₂ZnSnS₄は、1253 K で包晶反応により形成されるとあるが、こ の温度と一致していない。この原因ついては 後ほど詳細に述べる。また、1000 K 程度で、 構成元素の揮発に伴うと予測される重量減 少がわずかではあるが観測されることから、 この試料は窒素気流下中では、1000 K まで 化学的に安定であることが確認できた。それ に対し、大気中では830K付近から重量増加 がはじまり、920Kで発熱反応を伴う急激な 重量増加が起こる。これは、Cu₂ZnSnS₄の酸 化によるものと考えられる。830 K 以下では、 重量増加も熱の出入りもみられないことか ら、大気中においてはこの試料は、830Kま で化学的に安定であることがわかった。

次に、図 3(a), (b), (c)に電気抵抗率、ゼー ベック係数、パワーファクタの結果を示す。 空気中での Cu₂ZnSnS₄の ρ とSは、ヘリウ



図 2 . (a)窒素気流下、(b)大気気流下での Cu₂ZnSnS₄の TG-DTA カーブ .

ム雰囲気下でのデータとよく一致した。すな わち、Cu₂ZnSnS₄ は少なくとも測定時間内に おいては、300-720 K で化学的に安定である ことを示している。また、過去に報告されて いる Cu リッチな組成の試料のデータ(図 3 中紺色の で表示)ともよく似た値を示した。 具体的には、Cu₂ZnSnS₄ の ρ は、温度上昇と ともに 1.2 m Ω m (303 K)から 0.57 m Ω m (719 K)に減少した。S は、正の値をとり P 型の伝導を示し、99 μ VK⁻¹ (322 K)から、256 μ VK⁻¹ (706 K)に増加した。 $S^2\rho^{-1}$ は、温度上 昇とともに増加し、706 K で、0.12 mWm⁻¹ K⁻²に達した。

図 4(a)より、кが温度上昇ともに減少し、 289 Kで1.62 から721 Kで0.82 Wm⁻¹ K⁻¹ となった。この値は、二つの異なる文献から 報告されている Cu リッチな試料の値の間に 位置する。したがって、図3で述べた電気的 特性と同様、熱的特性も Cu リッチな試料と 良く似た値を持つことがわかった。本研究で 求めた電気的特性と熱的特性から熱電特性 を示す ZT を評価すると、720 K で0.1 を示 し、過去に報告されている Cu リッチな試料 の ZT とよく似た値を示すことがわかった。

続いて、実際の熱電モジュールとしての使 用を想定した条件を模擬した実験を行った。 大気中で Cu₂ZnSnS₄ をある温度で一定時間 (673 K で 24 時間)保持することで、長期間の 熱処理に耐えられるかどうかを確かめた。図 5 に、673 K で試料を保持した場合の、 ρ と 重量の初期値からの増分を、横軸時間でプロ ットした。その結果、重量は 24 時間後もほ



図 3. Cu₂ZnSnS₄の(a)電気抵抗率 ρ 、(b)ゼ ーベック係数 $S^2\rho^{-1}$ 、(c)パワーファクタ $S^2\rho^{-1}$ の温度依存性. [紺色のマークは H. Yang et al., *Nano Lett.* **12**, 540 (2012)の文献データ; 緑色のマークは X. Y. Shi et al, *APL* **94**, 122103 (2009)の文献データ]

ぼ変化しないのに対し、 ρ は24時間で6%も 増加する。したがって、TG-DTAでは検知で きないような変化が起こっていることが示 唆された。まず、はじめに我々は、 ρ の増大 が、 ρ を測定する際に使用したPtペーストが 試料に拡散したか、その逆の反応が起きた可 能性を考え、PtペーストをのせたCu₂ZnSnS4



図 4. Cu₂ZnSnS₄ の熱伝導率と無次元性能指数の温度依存性.[紺色のマークは H. Yang et al., *Nano Lett.* **12**, 540 (2012)の文献データ; 緑色のマークは X. Y. Shi et al, *APL* **94**, 122103 (2009)の文献データ]



図 5. 673 K でアニール処理した際の、 Cu₂ZnSnS₄の電気抵抗率ρと重量 TG の時間 変化(初期値を0として、増加割合%を縦軸 にプロットしている)

を大気中でアニールした試料を用意し、Pt と試料の界面から 30 μ m を分析した。その結 果、Cu₂ZnSnS4 側には Pt が最大で 10 at.% の割合で拡散しており、Pt 側も、Cu₂ZnSnS4 の各構成元素が 10at.%以内の割合で拡散し ていることがわかった。しかしながら、試料 のサイズ(3×3×12 mm³)に対して、双方 から拡散している部分が少なすぎるため、こ の拡散が試料の ρ に影響を与えているとは考 えにくい。さらに我々は、この分析の最中に、 Cu₂ZnSnS₄の構成元素である Cu, Zn, Sn, S の空間的分布が、Pt と Cu₂ZnSnS₄の界面か らの距離によらず、非常に大きいことに気が ついた。

そこで約 5×5×1 mm³のサイズの三種類の 焼結体を用意し、その表面を分析した。試料 は3つであり、放電プラズマ焼結した試料 (Sample A)、A を 673 K で 72 時間大気中で 熱処理した試料(Sample B)、Bの試料と同じ 処理ではあるが、Ptペーストを一部分につけ た試料(Sample C)を用意した。試料の観察前 に既に、Sample C は肉眼でも明らかな色の 違いがみられ、それは Pt ペーストを十分に 削り取った後でもみられた。表面の元素分析 の結果、Sample A と Sample B が均一であ るのに対し、Sample C は暗いマトリックス の粒界に明るい相が析出していた。詳細な分 析の結果、Sample C の明るい部分は、ZnS がリッチな組成になっていることが確認さ れた。



図 6. Zn 組成の標準偏差の観察表面積依存性

また図6に、観察表面の視野からランダムに 20 ポイント選び、組成分析を行った結果を基 に算出した、Zn 組成の標準偏差の観察視野 の面積依存性を示している。観察視野を小さ くするにしたがって、標準偏差は小さくなり、 Znの組成のばらつきは小さくなっているが、 44×33 µm の観察視野でも 14%の Zn 組成の 標準偏差をもっており、このサイズでも試料 が複相になっていることが示唆される。この ばらつきの大きさは、Cu₂S-SnS-ZnS の状態 図からも説明できる[I.D.Oleksevuk et al., J. Alloys Compd. 368, 135 (2004)] .Cu₂ZnSnS₄ は、Cu₂SnS+Cu₂ZnSnS₄とZnS+Cu₂ZnSnS₄ の2相混合領域の間の、非常に狭い領域に存 在する化合物であり、少しの組成のずれによ リ、ZnS, Cu₂S Cu₂SnS₃などの不純物が形成 される可能性がある。この結果を受けて、図 1で行った結晶構造解析を、ZnSと Cu₂ZnSnS₄の2相が存在するという仮定の もとやりなおすと、さらによりフィットが得

られた。したがって、この結果からも Sample A はそもそも複相であることが示唆された。 複相になる原因としては、試料の溶融過程や、 放電プラズマ焼結の過程が影響していると 考えられるが、過去の報告でもこれらの手法 が適用されていることから、これらの試料に ついても、我々と同様、複相になっている可 能性が高い。現在のところ、Ptペーストによ り、なぜ ZnS のミクロンオーダーの分離が促 されるかはわからないが、Pt は、Cu₂ZnSnS₄ と電極を接着させるペーストとしてはふさ わしくないことがわかった。したがって、今 後は Pt に変わる電極材料の選択や、Pt と Cu_2ZnSnS_4 の間にバリア層を形成するなど、 Cu₂ZnSnS₄の劣化をふせぐ重要性があるこ とを明らかにした。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計9件;主要な論文を抜粋)

"High-temperature Thermoelectric Properties and Thermal Stability in Air of Copper Zinc Tin Sulfide for the P-type Leg of Thermoelectric Devices", <u>Atsuko Kosuga</u>, Mie Matsuzawa, Akito Horie, Tatsuro Ohmoto, and Ryoji Funahashi,, *Jpn. J. Appl. Phys.* **54**, 0618011-0618016 (2015). 査読有

DOI: 10.7567/JJAP.54.061801

"Room-Temperature Pressure Induced Nanostructural CuInTe₂ Thermoelectric Material with Low Thermal Conductivity", <u>Atsuko Kosuga*</u>, Kouhei Umekage, Mie Matsuzawa, Yasuhiro Sakamoto, and Ikuya Yamada, *Inorg. Chem.* 53, 6844-6849 (2014). (June 10, 2014) 査読有

DOI: 10.1021/ic500688d

" Effect of Mixed Grain Sizes on the Thermoelectric Properties of Ca0.9Yb0.1MnO3", Tsubasa Fukui, Mie Matsuzawa, Ryoji Funahashi, and Atsuko Kosuga*, J. Electro. Mater. 43(6).DOI: 10.1007/s11664-013-2778-6

" Microstructure and thermoelectric properties of Ca_{0.9}Yb_{0.1}MnO₃/Pd nanocomposite prepared by electroless plating", <u>Atsuko Kosuga*</u>, Kazuyo Tsuchiya, and Mie Matsuzawa, *J. Alloys Compd.* **568**, 118-123 (2013). (August 2013) 查読有 **DOI:**

http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.03. 026

[学会発表](計37件;主要な発表を抜粋) "Novel Thermoelectric Materials and Applications", (Keynote), <u>Atsuko Kosuga</u> Sakon Nakhon Rajabhat University International Conference 2015 (SNRU-IC 20115), Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakhon Nakhon, Thailand, July 24(Fri), 2015.

"Analysis of thermoelectric transport of CuGaTe₂ prepared room-temperature high-pressure bv synthesis: experimental and theoretical study", Yosuke Fujii, Shyu Miyaue, Hiroki Funashima, Hiroshi Katayama-Yoshida, Ikuya Yamada, Atsuko Kosuga, The 34th International Conference Thermoelectrics (ICT2015), International Congress Center Dresden, Dresden. Germany, June 28(Sun)-July 2 (Thu), 2015.

"Pressure-mediated Control of Structure and Transport Property in Nanostructured Thermoelectric Bulk Chalcopyrite", <u>Atsuko Kosuga</u>*, Kouhei Umekage, Yousuke Fujii, Akito Horie, Mie Matsuzawa, Yasuhiro Sakamoto, and Ikuya Yamada, *The 15th IUMRS-International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014)*, Fukuoka University, Fukuoka, Japan, August 24-30, 2014

"Nanoscale Domain Disorder Induced by High Pressure Treatment at Room Temperature in Thermoelectric Bulk CuInTe₂ Matrix" (Invited), <u>Atsuko Kosuga</u>, Kouhei Umekage, Mie Matsuzawa, Yasuhiro Sakamoto, and Ikuya Yamada The 4th international Workshop on Thermoelectrics, Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Hyogo, Japan, July 4-6, 2013

"Effect of Mixed Grain Sizes on the Thermoelectric Properties of Ca_{0.9}Yb_{0.1}MnO₃" Tsubasa Fukui, Mie Matsuzawa, Ryoji Funahashi, and<u>Atsuko Kosuga</u> The 4th international Workshop on Thermoelectrics, Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island, Hyogo, Japan, July 4-6, 2013

"Pressure-mediated control of nanoscale-domain structures in thermoelectric chalcogenides as a new route to optimize thermoelectric performance", <u>Atsuko Kosuga</u>, Yasuhiro Sakamoto, and Ikuya Yamada, The 32nd International Conference on Thermoelectrics (ICT2013), Kobe International Conference, Center, Kobe, Japan, June 30(Sun)-July 4 (Thu), 2013.

"Effect of mixed grain sizes on the thermoelectric properties of Ca_{0.9}Yb_{0.1}MnO₃" Tsubasa Fukui, Mie Matsuzawa, Ryoji Funahashi, and <u>Atsuko</u> Kosuga, The 32nd International Conference on Thermoelectrics (ICT2013), Kobe International Conference, Center, Kobe, Japan, June 30(Sun)-July4 (Thu), 2013.

"Remarkable reduction of lattice thermal conductivity in thermoelectric chalcopyrites by high pressure treatment", Kouehei Umekage, Ikuya Yamada, Yasuhiro Sakamoto, and <u>Atsuko</u> <u>Kosuga</u>, The 32nd International Conference on Thermoelectrics (ICT2013), Kobe International Conference

Center, Kobe, Japan, June 30(Sun)-July 4(Thu), 2013.

「Cu含有カルコパイライト化合物の作製方 法と結晶構造及び熱電特性の関係」藤井洋輔、 小<u>菅厚子</u>、第十二回日本熱電学会学術講演会 (TSJ2015)、2015年9月7日(月)-8日(火)、 (於:九州大学筑紫地区総合研究棟)(福岡 県春日市)

「AgGaTe2カルコパイライト構造化合物の 高温安定性」、堀江晃斗、小<u>菅厚子</u> 第十二回日本熱電学会学術講演会(TSJ2015)、 2015 年 9 月 7 日 (月) -8 日 (火)(於:九 州大学筑紫地区総合研究棟)(福岡県春日市) 「Cu1-xAgxGaTe2 固溶体の室温高圧処理に

よる構造と熱電特性への影響」 藤井洋輔、山田幾也、小菅厚子、日本金属学 会 2015 年春季(第156回)講演大会、2015 年3月18日(水)-20日(金)(於:東京 大学駒場Iキャンパス)(東京都目黒区)

「Cu₂ZnSnS₄の大気中での高温安定性と熱 電特性」、小菅厚子、松沢美恵、舟橋良次、 第62回応用物理学会春季学術講演会、2015 年3月11日(水)-14日(土)(於:東海 大学 湘南キャンパス)(神奈川県平塚市)

「CuGaTe2の格子歪みと熱伝導率の処理圧 力依存性」、藤井洋輔、山田幾也、小菅厚子 粉体粉末冶金協会平成26年秋季大会(第 114回講演大会)2014年10月29日–31 日、(於;大阪大学コンベンションセンター) (大阪府吹田市)

「Zn0.03Cu0.97FeS2の高圧処理による熱電物 性の変化」、梅景康平、辻井直人、森孝雄、 山田幾也、小菅厚子、第十一回日本熱電学会 学術講演会(TSJ2014)、2014年9月29日-30 日、(於:独立行政法人物質・材料研究機構) (茨城県つくば市)

「室温高圧処理による AgGaTe2の構造と熱 電特性の変化」、堀江晃斗、山田幾也、小<u>菅</u> <u>厚子</u>、日本金属学会 2014 年秋季(第155 回)講演大会、2014 年 9 月 24 日-26 日、(於: 名古屋大学東山キャンパス)(愛知県名古屋 市) 「熱電材料 CuGaTe2の構造と熱伝導率の 処理圧力依存性」、藤井洋輔、山田幾也、小 <u>菅厚子</u>、日本金属学会 2014 年秋季(第155 回)講演大会、2014 年 9 月 24 日-26 日、(於: 名古屋大学東山キャンパス)(愛知県名古屋 市)

「Ca0.9Yb0.1MnO3 マイクロ/ナノコンポジ ット材料の熱電特性」、福井つばさ、松沢美 恵、舟橋良次、小菅厚子、日本金属学会 2012 年秋期大会、2013年9月17日-19日、(於: 金沢大学 角間キャンパス)(石川県金沢市)

〔図書〕(計2件)

<u>小菅厚子</u>、藤井洋輔、"ナノ構造制御バルク 熱電材料の研究動向と課題",熱電変換材料 実用・活用を目指した設計と開発~材料技術 /モジュール化/フレキシブル化/実用例 ~(情報機構),249 (81-93),(2014). R. Funahashi and <u>A. Kosuga</u>, "Naturally Nanostructured

Thermoelectric Oxides"

Thermoelectric Nanomaterials (Springer, Heidelberg), **182**, (353-363), (2013). http://link.springer.com/chapter/10.1007%2 F978-3-642-37537-8_15

〔その他〕

ホームページ等

http://www.nanosq.21c.osakafu-u.ac.jp/ttsl _lab/a_kosuga/index.html

6.研究組織

- (1) 研究代表者
- 小菅 厚子(KOSUGA Atsuko)
- 大阪府立大学・21 世紀科学研究機構・講師 研究者番号: 30379143
- (2) 研究分担者なし

(3) 連携研究者なし